

Кремниевый фотодетекторный чип 680×680 мкм — техническое описание

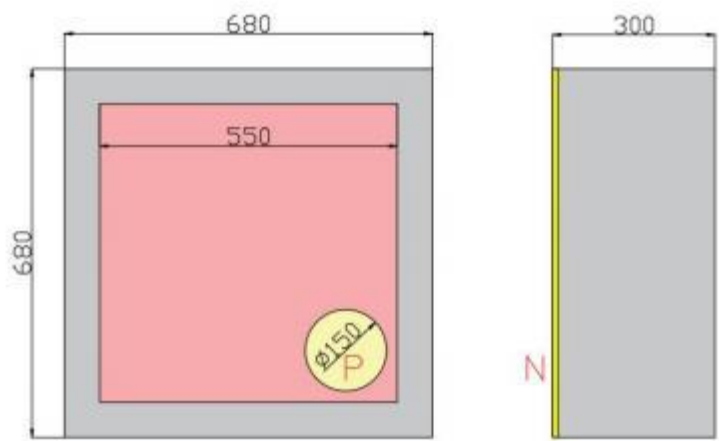
P/N : WS95-01C

Особенности

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод; электроды: задняя сторона (катод) — Au, верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	550x 550± 15			мкм
Ширина чипа	680±40			мкм
Длина чипа	680±40			мкм
Высота чипа	280	300	320	мкм
Размер контактной площадки	140	150	160	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir =100μA	60			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Обратный световой ток	IL	01V, 1 mW/cm2 @660nm	0.4			мкА
Рабочий диапазон длин волн	λ		430		1100	нм
Емкость	Cj	VR=3V, H=0, F=1MHz		9		пФ